

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形トランジスタ

2SD361

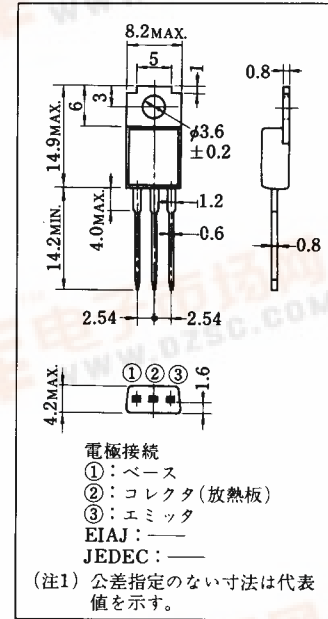
低周波電力増幅用(5~10W出力用)

- $h_{FE}$  の直線性が良い。
- モールドパワートランジスタで、小形かつ取付けが容易です。
- 2SB524 とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

最大定格 (周囲温度 25℃)

項 目	記 号	定 格 値	単 位	
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	60	V	
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	5	V	
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	40	V	
コレクタ電流	$I_C$	1.5	A	
せん頭コレクタ電流	$I_{CM}$	3	A	
コレクタ損失	$T_a=25^\circ\text{C}$	$P_C$	1	W
	$T_c=25^\circ\text{C}$	$P_C$	10	W
接合部温度	$T_j$	+150	℃	
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	℃	

外形図 単位:mm



電気的特性 (周囲温度 25℃)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$	60	—	—	V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10\text{mA}, R_{BE}=\infty$	40	—	—	V
コレクタしや断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=25\text{V}, I_E=0$	—	—	1	$\mu\text{A}$
エミッタしや断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$	—	—	1	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=0.5\text{A}$ , パルステスト	55	110	300	—
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=1\text{A}, I_B=0.05\text{A}$	—	—	1	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=0.05\text{A}$	—	0.7	—	V

$h_{FE}$  の値により下表のようにアイテム分類を行なっています。

アイテム	C	D	E
$h_{FE}$	55~110	90~180	150~300

